T. YK107/7518

深見特許事務所

弁理士 深見 久郎 先生

FAX NO. : 06-6361-1731(総7頁)

ONFIRMATION



2002年 4月 30 日

KIM & CHANG

金·張 特許法律事務所 韓国ソウル特別市鍾路区雲泥洞114-31、ソウルビル

話:82-2-764-8855(代) フアクシミリ:82-2-741-0328.745-5954 ื

:82-2-763-7434(商標)

E-mail: all@ip.kimchang.com

具 弁理士 永

弁理士

李 中

朱 成 民

弁理士



韓国特許出願第10-2000-0019953号

三菱電機株式会社 出願人:

三菱電機事件番号:516932KR01 999097-03(YB/my)**貴軽理番号**:

当整理番号: PE-001305/SHE

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、標題の出願につきまして、特許庁から意見提出通知書を受け取りましたので お知らせ申し上げます。この件に係る意見提出通知書に対する意見書提出期限は20 02年6月25日までであり、申請によって1ケ月ずつ期間延長が可能でございます。

- 意見提出通知書に引用された文献の写し(By Airmail)
- 意見提出通知書に関する私共の検討結果並びにコメントは近いうちにお送り致 します。

敬 具

同封書類:意見提出通知書の写し及びその和訳文 各1诵

T.YK491

発送日付:2002.04.25 提出期限:2002.06.25

特 許 庁 意見提出通知書

出 願 人 氏 名 三菱電機株式会社 外2人

住 所 日本国東京都千代田区丸の内二丁目2-3

代理人 氏名 張秀吉外1人

住 所 ソウル市鍾路区内資洞 219 ハンヌリビル

(金・張特許法律事務所)

出願番号 10-2000-0019953

発明の名称 フォトマスクの洗浄方法、洗浄装置およびフォトマスクの洗浄液

本出願に対する審査結果、以下のような拒絶理由があり特許法第63条の規定によりこれを通知するので、意見があるか補正を行う必要がある場合は上記期限までに意見書又は/及び補正書を提出されたい(上記期限について毎回1ヵ月単位で延長を申請することができ、この申請について別途の期間延長承認通知はしない)。

[理由]

本出願の特許請求範囲第1~3項に記載された発明は、その出願以前にこの発明が属する技術分野において、通常の知識を有する者が下記に指摘されたものにより容易に発明できたものと認められるので、特許法第29条第2項の規定に該当し特許を受けることができない。

本願発明の請求項1~3は、マスク表面に存在する有機物及び金属不純物を除去する第1段階、異物質を水素ガス溶解水で除去する第2段階、乾燥させる第3段階からなる洗浄方法及び水素ガス溶解水が含まれた洗浄液に関するものであって、これは日本公開特許平成11-29794号(公開日1999.2.2引用発明1)の微粒子で汚染された電子材料の洗浄水である水素ガスを供給し、洗浄水に超音波を照射する方法及び金属分を。

,E^

除去する RCA 洗浄法と、日本公開特許平成 11·7892 号(公開日 1999.1.12 引用発明 2) の洗浄槽に沈積した後、外部に設置された超音波によって異物質が除去され、次にすすぎ過程を経て乾燥工程を経る段階を備えた洗浄装置及び方法と、日本公開特許平成 10·317182 号(公開日 1998.12.2 引用発明 3)の塩化物とフッ素系溶剤及びイオンなどの塩化物を除去する洗浄装置から容易に発明できたものである。

[添付]

添付1 日本公開特許平成 11-29794 号

添付2 日本公開特許平成 11-7892 号

添付3 日本公開特許平成 10:317182 号

2002年 4月 25日

特 許 庁 審查4局

半導体1審査担当官室 審査官 イト・ウ ルン

007518

출력 일자: 2002/4/26

10-053

19)

발송번호: 9-5-2002-014327993

수신 : 서울 종로구 내자동 219 한누리빌딩(김&

발송일자 : 2002.04.25

장 특허법률사무소)

제출기일: 2002.06.25

장수길 귀하

특허청 의견제출통지서

RECEIVED KIM & CHANG

APR. 2 6. 2002

5/6

명칭 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 외 2명 (출원인

주소 일본국 도쿄도 지요다쿠 마루노우치 2쵸메 2반 3고

대리인

출원인

성명 장수길 외 1명

주소 서울 종로구 내자동 219 한누리빌딩(김&장 특허법률사무소)

출원번호

10-2000-0019953

발명의 명칭

포토마스크의 세정 방법, 세정 장치 및 포토마스크의 세정액

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 통지하 오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서 또는/및 보정서를 제출하여 주시기 바랍니다. (상기 제출기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통지는 하지 않습니다.)

[이 유]

이 출원의 특허청구범위 제1항 내지 제3항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야 에서 통상의 지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허 법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

본원발명의 청구항1 내지 청구항3은 미스크표면에 존재하는 유기물 및 금속불순물을 제거하는 제1 단계, 이물질을 수소가스용해수로 제거하는 제2단계, 건조시키는 제3단계로 이루어진 세정방법 및 세정방법 그리고 수소가스용해수가 포함된 세정액에 관한 것으로서, 이는 일본공개특허 평성 11-29794호(공개일 1999, 2, 2, 인용발명1)의 미립자로 오염된 전자재료의 세척수인 수소가스를 공급하고 세척수에 초음파를 조사하는 방법 및 금속분을 제거하는 RCA 세척법과 일본공개특허 평성 11-7892호(공개일 99, 1, 12, 인용발명2)와 세척조에 침적한 뒤 외부에 설치된 초음파에 의하여 이물질이 제거되며, 다음에 행굼과정을 거쳐 건조공정을 거치는 단계를 구비한 세정장치 및 방법과 일본공개특허 평성10-317182호(공개일 98, 12, 2, 인용발명3)의 염화물과 불소계용제 및 이온등의 염화물을 제거하는 세정장치로부터 용이하게 발명할 수 있습니다. 끝.

[첨 부]

첨부 1 일본공개특허 평성11-29794호 첨부2 일본공개특허 평성11-7892호

첨부3 일본공개특허 평성10-317182호 끝.

2002.04.25

특허청

심사4국

반도체1 심사담당관실

심사관 이두한

출력 일자: 2002/4/26

<<안내>>

문의사항이 있으시면 🟗 042)-481-5983 로 문의하시기 바랍니다.

목허청 직원 모두는 깨끗한 목허행정의 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 만일 업무처리과정에서 직원의 부조리행 위가 있으면 신고하여 주시기 바랍니다. ▶ 용페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터